

	<h2>NTD5807NT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTD5807NT4G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 23A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD5807NT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 117698 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTD5807NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 23A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	117698 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	33W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	603pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















NTD5807NT4G ist neu im Original, Suche NTD5807NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5807NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5807NT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>NTD5807NG</b> O NTD5807NG O	 <b>NTD5862N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 90A DPAK	 <b>NTD5865N-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 43A DPAK	 <b>NTD5862N</b> ON NTD5862N ON
 <b>NTD5807N</b> ON NTD5807N ON	 <b>NTD5806NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 33A DPAK	 <b>NTD5806NG</b> VB NTD5806NG VB	 <b>NTD5865NL</b> ON NTD5865NL ON

### heiße Teile

Mehr

 NTD5406T4G	 NTD5407N	 NTD5407NG	 NTD5407NT4G	 NTD5412NT4G
 NTD5413N	 NTD5413NT4G	 NTD5414N	 NTD5414NT4G	 NTD5426NT4G
 NTD5802N	 NTD5802NT4G	 NTD5803N	 NTD5803NT4G	 NTD5804N
 NTD5804NG	 NTD5804NT4G	 NTD5805N	 NTD5805NG	 NTD5805NT4G
 NTD5806N	 NTD5806NG	 NTD5806NT4G	 NTD5807N	 NTD5807NG
 NTD5862N	 NTD5862NT4G	 NTD5865N-1G	 NTD5865NL	 NTD5865NL-1G
 NTD5865NLT4G	 NTD5865NT4G	 NTD5867NL	 NTD5867NL-1G	 NTD5867NLG
 NTD5867NLT4G	 NTD5867NT4G	 NTD60N02KG	 NTD60N02R	 NTD60N02R-001
 NTD60N02R-032	 NTD60N02R-035	 NTD60N02R-1G	 NTD60N02R-1R	 NTD60N02R-35G
 NTD60N02RG	 NTD60N02RG-1G	 NTD60N02RT	 NTD60N02RT4	 NTD60N02RT4G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited